

## **The Data Book Project**

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

**Scroll down to see the scanned document.**

# FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

**最新トランジスタ規格表** (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T <sub>b</sub> =25°C)					電 気 的 特 性 (T <sub>b</sub> =25°C)										外 形	備 考
				V <sub>ceo</sub> (V)	V <sub>ceo</sub> (V)	I <sub>c</sub> (mA)	P <sub>c</sub> (mW)	T <sub>j</sub> (°C)	I <sub>ceo</sub> 最大値 (μA)	直流又はパルスI <sub>BE</sub>		バイアス		h <sub>FE</sub>	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (Ω)	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (×10 <sup>-4</sup> )	h <sub>FE</sub> h <sub>FE</sub> * (μS)	f <sub>αb</sub> f <sub>r</sub> * (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I<sub>CBO</sub> MAXIMUM VALUE AND V<sub>CB</sub> VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I<sub>CBO</sub>)
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h<sub>FE</sub> AND V<sub>CE</sub>, I<sub>C</sub> (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h<sub>FE</sub>)
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V<sub>CB</sub>, I<sub>E</sub> (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- \* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
  - 9 f<sub>αb</sub> OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF \* WHICH INDICATES VALUE OF f<sub>r</sub>.
  - 10 C<sub>ob</sub> AND r<sub>bb'</sub> OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF \* IN r<sub>bb'</sub> COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h<sub>ie</sub> (real)
  - 11 OUTLINE
  - 12 REMARKS
- :とコンプリ: COMPLEMENTARY TO .....

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T <sub>a</sub> = 25°C)					電 気 的 特 性 (T <sub>a</sub> = 25°C)											外形	備考			
				V <sub>CB0</sub> (V)	V <sub>SBO</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	P <sub>C</sub> (mW)	T <sub>J</sub> (°C)	I <sub>CB0</sub> 最大値		直流又はパルス h <sub>FE</sub>		バイアス		h <sub>FE</sub>	h <sub>FE</sub> *	h <sub>FE</sub> (×10 <sup>-4</sup> )	h <sub>FE</sub> (μU)	f <sub>α0</sub> f <sub>T</sub> * (Mc)			C <sub>ob</sub> (pF)	r <sub>bb'</sub> h <sub>ie</sub> (real)* (Ω)	
									(μA)	V <sub>CE</sub> (V)	V <sub>CE</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	I <sub>E</sub> (mA)										h <sub>FE</sub> *
2SD1017	日電	PA	Si.T	250	5	2A	50W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	200	40~250	10	400									162		
" 1018	"	"	"	250	5	4A	80W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	200	40~250	10	500									162		
" 1019																								
" 1020	日電	AF	Si.E	30	5	700	350	150	0.1	30	200	1	100	6	-10					170*	13	42	2SB810 とコンプリ	
" 1021	"	PA	"	30	5	1A	350	150	0.1	30	200	1	100	6	-10					130*	22	42	2SB811 とコンプリ	
" 1022	新電元	SW	Si.T	100	7	5A	30W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	100	>1500	3	3A									268	ダーリントン T5L10	
" 1023																								
" 1024	新電元	SW	Si.T	100	7	8A	50W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	100	>1500	3	5A									268	ダーリントン T8L10	
" 1025																								
" 1026																								
" 1027																								
" 1028																								
" 1029	三洋	PA	Si.TP	60	5	4A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	40	120	2	1A									268		
" 1030	松下	AF	Si.EP	50	15	50	200	125	0.1	20	400~2000	10	2							120*	2.6	176		
" 1031	サンケン	PA	Si.TMe	120	6	6A	50W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	120	4000	2.2	4A									298	ダーリントン	
" 1032	松下	"	Si.TP	60	5	4A	60W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	400	60	40~250	4	3A									152	2SB612 とコンプリ	
" 1033	日電	"	Si.T	200	5	2A	20W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	50	150	40~200	10	400	10	-400							185	2SB768 とコンプリ	
" 1034																								
" 1035	富士通	SW	Si.P	150	100	3A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	1	80	50	4	1A									268	ダーリントン	
" 1036	"	"	"	150	160	15A	150W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	1	80	35	4	5A									163		
" 1037	"	"	"	150	100	30A	180W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	5	80	35	4	10A									163		
" 1038	"	"	"	150	100	40A	180W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	5	30	40	4	15A									163		
" 1039	"	"	"	150	100	3A	40W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	1	80	50	4	1A									99		
" 1040	"	"	"	150	100	15A	150W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	1	80	35	4	5A									102		
" 1041	"	"	"	150	100	30A	180W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	5	80	35	4	10A									102		
" 1042	"	"	"	150	100	40A	180W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	5	80	40	4	15A									102		
" 1043	松下	PA	Si.TP	430	10	5A	80W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	1mA	300	1000	5	5A									102	ダーリントン	
" 1044	"	"	Si.DJ	100	6	6A	60W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	10	100	700~10000	4	1A									152	ダーリントン	
" 1045	日立	AF.SW	Si.E	30	6	3A	900	150	1	10	160~800	2	100	2	-100						200*	30	251	
" 1046	三洋	PA.SW	Si.P	150	6	8A	80W (T <sub>c</sub> =25°C)	150	100	80	60~200	5	1A	5	-1A						15*	160	155	2SB616 とコンプリ